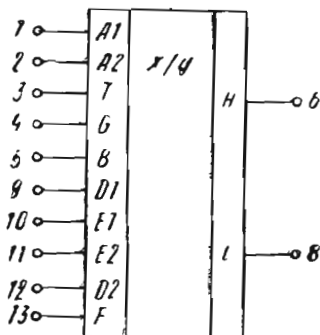


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 — вход исключения двух триггеров $A1$ | 8 — выход начала отсчета C |
| 2 — вход исключения триггера $A2$ | 9 — вход действия $D1$ |
| 3 — вход генератора T | 10 — вход «пуск» $E1$ |
| 4 — запуск генератора G | 11 — вход «установка» $E2$ |
| 5 — вход генератора B | 12 — вход разрешения выхода $D2$ |
| 6 — выход H | 13 — вход «сброс» F |
| 7 — общий | 14 — +5 В |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

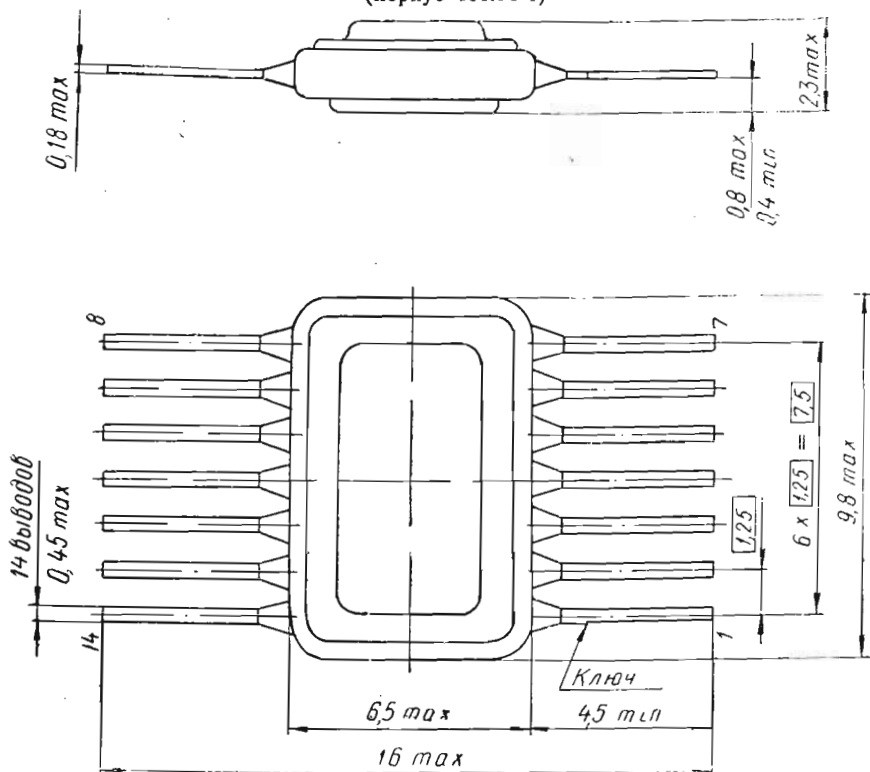
(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$5 \pm 20\%$
Ток потребления, мкА, не более:	
при высоком (низком) уровне выходного напряжения	20
в динамическом режиме:	
при $f=40$ кГц	100
» $f=80$ кГц	400
в режиме «сброс»	28
Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более:	
для выхода 6	0,2
» » 8	$0,2 U_n$
высокого уровня, не менее:	
для выхода 6	$0,85 U_n$

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ (корпус 401.14-4)



Масса не более 0,45 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	400 (40)
Механический удар:	
одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$ (g)	10 000 (1000)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 512

Общие данные

многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, $\text{м}\cdot\text{с}^{-2}$ (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	150
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт.ст.)	
для микросхемы 512ПС10	$1,3 \cdot 10^{-4}$ (10^{-6})
» остальных микросхем	665 (5)
Атмосферное повышенное давление, атм	
	3
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10	100
» остальных микросхем	85
Пониженная температура среды, °С	
	минус 60
Изменения температуры среды, °С:	
для микросхемы 512ПС10	от минус 60 до +100
» остальных микросхем	от минус 60 до +85
Повышенная относительная влажность при 35°С, %	
	98
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка*, ч	50 000
Срок сохраняемости*, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11.073.041—82, ОСТ 11 073.040—82 и требованиями, изложенными ниже.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

Установка микросхем на платы при монтаже осуществляется вплотную или с зазором не более 0,7 мм с последующей прилакировкой или приклейкой.

Допускается установка микросхем с использованием прокладки, заполняющей зазор.

При всех режимах монтажа на платах температура на корпусе микросхемы не должна превышать предельно допустимую температуру.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.